



Рис. 8. Вольт-амперная (α) и вольт-фарадная (β) характеристики тонкой пленки оксида циркония, легированного оксидом иттрия, на кремнии

Fig. 8. Volt-ampere (a) and voltage-farad (b) characteristics of thin film of yttria doped zirconium oxide on silicon substrate